

**Rohm**<sup>®</sup>  
QUALITY · RELIABILITY



# 2SC2060

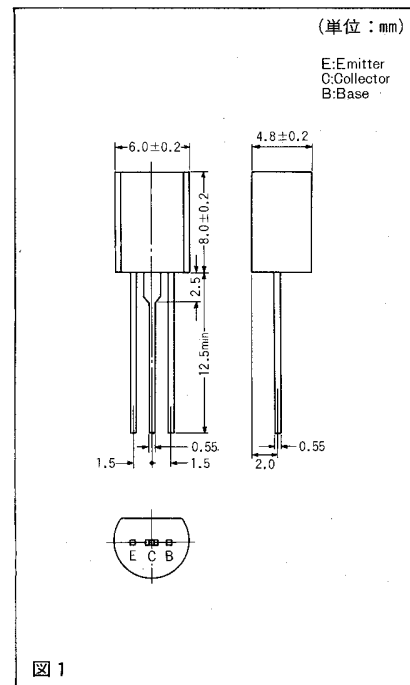
トランジスタ

NPN  
type

NPN エピタキシャルプレーナ型  
シリコントランジスタ

## 1~2W低周波出力用

### ■ 外形寸法図 (Physical Dimension)



### ■ 絶対最大定格 (Ta=25°C) (Absolute Maximum Ratings)

項目	記号	定格	単位
コレクタベース間電圧	V <sub>CB0</sub>	40	V
コレクタエミッタ間電圧	V <sub>CEO</sub>	32	V
エミッタベース間電圧	V <sub>EBO</sub>	5	V
コレクタ電流	I <sub>c</sub>	1 2*	A dc A pulse
コレクタ損失	P <sub>c</sub>	750	mW
ジャンクション温度	T <sub>j</sub>	125	°C
保存温度	T <sub>stg</sub>	-55~125	°C

\*1 Pw=20m sec, duty=1/2

### ■ 電気的特性 (Ta=25°C) (Electrical Characteristics)

項目	記号	MIN	TYP	MAX	単位	条件
コレクタエミッタ降伏電圧	BV <sub>CEO</sub>	32	—	—	V	I <sub>c</sub> =1mA
コレクタベース降伏電圧	BV <sub>CB0</sub>	40	—	—	V	I <sub>c</sub> =50μA
エミッタベース降伏電圧	BV <sub>EBO</sub>	5	—	—	V	I <sub>E</sub> =50μA
コレクタシャ断電流	I <sub>CB0</sub>	—	—	0.5	μA	V <sub>CB</sub> =20V
エミッタシャ断電流	I <sub>EBO</sub>	—	—	0.5	μA	V <sub>EB</sub> =4V
コレクタエミッタ飽和電圧	V <sub>CE (sat)</sub>	—	—	0.4	V	I <sub>c</sub> /I <sub>B</sub> =500mA/50mA
直流電流増幅率	h <sub>FE</sub>	82	—	390	—	V <sub>CE</sub> =3V, I <sub>C</sub> =100mA
利得帯域幅積	f <sub>T</sub>	50	150	—	MHz	V <sub>CE</sub> =5V, I <sub>E</sub> =-50mA
出力容量	C <sub>ob</sub>	—	15	30	pF	V <sub>CB</sub> =10V, I <sub>E</sub> =0, f=1MHz

h<sub>FE</sub> の値により下表のように分類します。

アイテム	P	Q	R
h <sub>FE</sub>	82~180	120~270	180~390

2SC2060